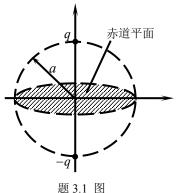
第三章习题及解答

- 真空中半径为a的一个球面,球的两极点处分别设置点电荷q和-q,试计算球赤道平 面上电通密度的通量 Φ (如题 3.1 图所示)。
 - 由点电荷q和-q共同产生的电通密度为



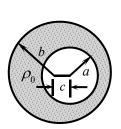
$$D = \frac{q}{4\pi} \left[\frac{R_{+}}{R_{+}^{3}} - \frac{R_{-}}{R_{-}^{3}} \right] = \frac{q}{4\pi} \left\{ \frac{e_{r}r + e_{z}(z-a)}{\left[r^{2} + (z-a)^{2}\right]^{3/2}} - \frac{e_{r}r + e_{z}(z+a)}{\left[r^{2} + (z+a)^{2}\right]^{3/2}} \right\}$$

则球赤道平面上电通密度的通量

$$\Phi = \int_{S} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_{S} \mathbf{D} \cdot \mathbf{e}_{z} \Big|_{z=0} dS = \frac{q}{4\pi} \int_{0}^{a} \left[\frac{(-a)}{(r^{2} + a^{2})^{3/2}} - \frac{a}{(r^{2} + a^{2})^{3/2}} \right] 2\pi r dr = \frac{qa}{(r^{2} + a^{2})^{1/2}} \Big|_{0}^{a} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1 \right) q = -0.293q$$

3.2 1911 年卢瑟福在实验中使用的是半径为 r_a 的球体原子模型,其球体内均匀分布有总电 荷量为 – Ze 的电子云,在球心有一正电荷 Ze (Z 是原子序数,e 是质子电荷量),通过实验得 到球体内的电通量密度表达式为 $\mathbf{D}_0 = \mathbf{e}_r \frac{Ze}{4\pi} \left(\frac{1}{r^2} - \frac{r}{r^3} \right)$, 试证明之。

位于球心的正电荷 Ze 球体内产生的电通量密度为 $\mathbf{D}_1 = \mathbf{e}_r \frac{Ze}{4\pi r^2}$



原子内电子云的电荷体密度为

$$\rho = -\frac{Ze}{4\pi r_a^3/3} = -\frac{3Ze}{4\pi r_a^3}$$

电子云在原子内产生的电通量密度则为
$$\mathbf{D}_2 = \mathbf{e}_r \frac{\rho 4\pi r^3/3}{4\pi r^2} = -\mathbf{e}_r \frac{Ze}{4\pi} \frac{r}{r_a^3}$$

故原子内总的电通量密度为

$$\boldsymbol{D} = \boldsymbol{D}_1 + \boldsymbol{D}_2 = \boldsymbol{e}_r \frac{Ze}{4\pi} \left(\frac{1}{r^2} - \frac{r}{r_a^3} \right)$$

题 3.3 图 (a)

- **3.3** 电荷均匀分布于两圆柱面间的区域中,体密度为 ρ_0 C/m^3 ,两圆柱 面半径分别为a 和b, 轴线相距为C(c < b - a), 如题 3.3 图(a)所示。求空间各部分的电场。
- 由于两圆柱面间的电荷不是轴对称分布,不能直接用高斯定律求解。但可把半径为a的 小圆柱面内看作同时具有体密度分别为 $\pm \rho_0$ 的两种电荷分布,这样在半径为b的整个圆柱体内具 有体密度为 ρ_0 的均匀电荷分布,而在半径为a的整个圆柱体内则具有体密度为 $-\rho_0$ 的均匀电荷 分布,如题 3.3 图(b)所示。空间任一点的电场是这两种电荷所产生的电场的叠加。

在r>b区域中,由高斯定律 $\oint_S E \cdot dS = \frac{q}{\varepsilon_0}$,可求得大、小圆柱中的正、负电荷在点P产生

的电场分别为
$$\boldsymbol{E}_1 = \boldsymbol{e}_r \frac{\pi b^2 \rho_0}{2\pi \varepsilon_0 r} = \frac{\rho_0 b^2 \boldsymbol{r}}{2\varepsilon_0 r^2} \qquad \boldsymbol{E}_1' = \boldsymbol{e}_r' \frac{-\pi a^2 \rho_0}{2\pi \varepsilon_0 r'} = -\frac{\rho_0 a^2 \boldsymbol{r}'}{2\varepsilon_0 r'^2}$$

题 3.3 图 (b)

点
$$P$$
 处总的电场为
$$E = E_1 + E_1' = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} \left(\frac{b^2 \mathbf{r}}{r^2} - \frac{a^2 \mathbf{r'}}{r'^2} \right)$$

在 $r < b \perp r' > a$ 区域中,同理可求得大、小圆柱中的正、负电荷在点P产生的电场分别为

$$\boldsymbol{E}_{2} = \boldsymbol{e}_{r} \frac{\pi r^{2} \rho}{2\pi \varepsilon_{0} r} = \frac{\rho \boldsymbol{r}}{2\varepsilon_{0}} \qquad \boldsymbol{E}_{2}' = \boldsymbol{e}_{r}' \frac{-\pi a^{2} \rho}{2\pi \varepsilon_{0} r'} = -\frac{\rho a^{2} \boldsymbol{r}'}{2\varepsilon_{0} r'^{2}}$$

点
$$P$$
 处总的电场为
$$E = E_2 + E_2' = \frac{\rho_0}{2\varepsilon_0} (r - \frac{a^2 r'}{r'^2})$$

在r' < a的空腔区域中,大、小圆柱中的正、负电荷在点P产生的电场分别为

$$\boldsymbol{E}_{3} = \boldsymbol{e}_{r} \frac{\pi r^{2} \rho_{0}}{2\pi \varepsilon_{0} r} = \frac{\rho_{0} \boldsymbol{r}}{2\varepsilon_{0}} \qquad \boldsymbol{E}_{3}' = \boldsymbol{e}_{r}' \frac{-\pi r'^{2} \rho_{0}}{2\pi \varepsilon_{0} r'} = -\frac{\rho_{0} \boldsymbol{r}'}{2\varepsilon_{0}}$$

点
$$P$$
 处总的电场为
$$E = E_3 + E_3' = \frac{\rho_0}{2\varepsilon_0} (r - r') = \frac{\rho_0}{2\varepsilon_0} c$$

3.4 半径为a的球中充满密度 $\rho(r)$ 的体电荷,已知电位移分布为

$$D_r = \begin{cases} r^3 + Ar^2 & (r \le a) \\ \frac{a^5 + Aa^4}{r^2} & (r \ge a) \end{cases}$$
 其中 A 为常数,试求电荷密度 $\rho(r)$ 。

解: 由
$$\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho$$
,有
$$\rho(r) = \nabla \cdot \boldsymbol{D} = \frac{1}{r^2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d} r} (r^2 D_r)$$

故在
$$r < a$$
区域
$$\rho(r) = \varepsilon_0 \frac{1}{r^2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} [r^2(r^3 + Ar^2)] = \varepsilon_0 (5r^2 + 4Ar)$$

在
$$r > a$$
区域
$$\rho(r) = \varepsilon_0 \frac{1}{r^2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} \left[r^2 \frac{(a^5 + Aa^4)}{r^2} \right] = 0$$

3.5 一个半径为a薄导体球壳内表面涂覆了一薄层绝缘膜,球内充满总电荷量为Q为的体电荷,球壳上又另充有电荷量Q。已知球内部的电场为 $E = e_r(r/a)^4$,设球内介质为真空。计算: (1) 球内的电荷分布; (2) 球壳外表面的电荷面密度。

解 (1) 由高斯定律的微分形式可求得球内的电荷体密度为

$$\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \boldsymbol{E} = \varepsilon_0 \left[\frac{1}{r^2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} (r^2 E) \right] = \varepsilon_0 \left[\frac{1}{r^2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} (r^2 \frac{r^4}{a^4}) \right] = 6\varepsilon_0 \frac{r^3}{a^4}$$

(2) 球体内的总电量
$$Q$$
 为 $Q = \int_{0}^{\pi} \rho d\tau = \int_{0}^{a} 6\varepsilon_0 \frac{r^3}{a^4} 4\pi r^2 dr = 4\pi\varepsilon_0 a^2$

球内电荷不仅在球壳内表面上感应电荷-Q,而且在球壳外表面上还要感应电荷Q,所以球壳外表面上的总电荷为2Q,故球壳外表面上的电荷面密度为 $\sigma = \frac{2Q}{4\pi a^2} = 2\varepsilon_0$

3.6 两个无限长的同轴圆柱半径分别为r=a和r=b (b>a),圆柱表面分别带有密度为 σ_1 和 σ_2 的面电荷。(1) 计算各处的电位移 \boldsymbol{D}_0 ; (2) 欲使r>b区域内 $\boldsymbol{D}_0=0$,则 σ_1 和 σ_2 应具有什么关系?

解 (1) 由高斯定理
$$\oint_{S} \mathbf{D}_{0} \cdot \mathbf{d} \mathbf{S} = q$$
, 当 $r < a$ 时,有 $\mathbf{D}_{01} = 0$ 当 $a < r < b$ 时,有 $2\pi r D_{02} = 2\pi a \sigma_{1}$,则 $\mathbf{D}_{02} = \mathbf{e}_{r} \frac{a \sigma_{1}}{r}$ 当 $b < r < \infty$ 时,有 $2\pi r D_{03} = 2\pi a \sigma_{1} + 2\pi b \sigma_{2}$,则 $\mathbf{D}_{03} = \mathbf{e}_{r} \frac{a \sigma_{1} + b \sigma_{2}}{r}$ (2) 令 $\mathbf{D}_{03} = \mathbf{e}_{r} \frac{a \sigma_{1} + b \sigma_{2}}{r} = 0$,则得到 $\frac{\sigma_{1}}{\sigma_{r}} = -\frac{b}{a}$

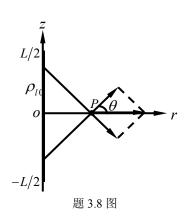
3.7 计算在电场强度 $E = e_x y + e_y x$ 的电场中把带电量为 -2μ C 的点电荷从点 $P_1(2,1,-1)$ 移到点 $P_2(8,2,-1)$ 时电场所做的功: (1) 沿曲线 $x = 2y^2$; (2) 沿连接该两点的直线。

解 (1)
$$W = \int_{C} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = q \int_{C} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = q \int_{C} E_{x} dx + E_{y} dy =$$

$$q \int_{C} y dx + x dy = q \int_{1}^{2} y d(2y^{2}) + 2y^{2} dy = q \int_{1}^{2} 6y^{2} dy = 14q = -28 \times 10^{-6} (J)$$

(2) 连接点 $P_1(2,1,-1)$ 到点 $P_2(8,2,-1)$ 直线方程为

- **3.8** 长度为L的细导线带有均匀电荷,其电荷线密度为 ρ_{l0} 。(1) 计算线电荷平分面上任意点的电位 φ ; (2) 利用直接积分法计算线电荷平分面上任意点的电场E, 并用 $E = -\nabla \varphi$ 核对。
- **解** (1) 建立如题 3.8 图所示坐标系。根据电位的积分表达式,线电荷平分面上任意点 P 的电位为



$$\varphi(r,0) = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{\rho_{l0} dz'}{4\pi\varepsilon_0 \sqrt{r^2 + z'^2}} = \frac{\rho_{l0}}{4\pi\varepsilon_0} \ln(z' + \sqrt{r^2 + z'^2}) \Big|_{-L/2}^{L/2} = \frac{\rho_{l0}}{4\pi\varepsilon_0} \ln \frac{\sqrt{r^2 + (L/2)^2} + L/2}{\sqrt{r^2 + (L/2)^2} - L/2} = \frac{\rho_{l0}}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{\sqrt{r^2 + (L/2)^2} + L/2}{r}$$

(2) 根据对称性,可得两个对称线电荷元 ρ_{10} dz'在点P的电场为

$$dE = e_r dE_r = e_r \frac{\rho_{l0} dz'}{2\pi\epsilon_0 \sqrt{r^2 + z'^2}} \cos \theta = e_r \frac{\rho_{l0} r dz'}{2\pi\epsilon_0 (r^2 + z'^2)^{3/2}}$$

故长为L的线电荷在点P的电场为

$$\boldsymbol{E} = \int \mathrm{d}\boldsymbol{E} = \boldsymbol{e}_r \int_0^{L/2} \frac{\rho_{l0} r \mathrm{d}z'}{2\pi\varepsilon_0 (r^2 + {z'}^2)^{3/2}} = \boldsymbol{e}_r \frac{\rho_{l0}}{2\pi\varepsilon_0 r} (\frac{z'}{\sqrt{r^2 + {z'}^2}}) \bigg|_0^{L/2} = \boldsymbol{e}_r \frac{\rho_{l0}}{4\pi\varepsilon_0 r} \frac{L}{\sqrt{r^2 + (L/2)^2}}$$

由 $\boldsymbol{E} = -\nabla \varphi$ 求 \boldsymbol{E} , 有

$$E = -\nabla \varphi = -\frac{\rho_{l0}}{2\pi\varepsilon_0} \nabla \left[\ln \frac{L/2 + \sqrt{r^2 + (L/2)^2}}{r} \right] =$$

$$-e_r \frac{\rho_{l0}}{2\pi\varepsilon_0} \frac{d}{dr} \left[\ln \left(L/2 + \sqrt{r^2 + (L/2)^2} \right) - \ln r \right] =$$

$$-e_r \frac{\rho_{l0}}{2\pi\varepsilon_0} \left\{ \frac{r}{\left[L/2 + \sqrt{r^2 + (L/2)^2} \right] \sqrt{r^2 + (L/2)^2}} - \frac{1}{r} \right\} = e_r \frac{\rho_{l0}}{4\pi\varepsilon_0 r} \frac{L}{\sqrt{r^2 + (L/2)^2}}$$

3.9 已知无限长均匀线电荷 ρ_l 的电场 $E = e_r \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0 r}$, 试用定义式 $\varphi(r) = \int_r^{r_p} E \cdot \mathrm{d} \boldsymbol{l}$ 求其电位函数。其中 r_p 为电位参考点。

解
$$\varphi(r) = \int_{r}^{r_p} \boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{l} = \int_{r}^{r_p} \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0 r} dr = \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0} \ln r \Big|_{r}^{r_p} = \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{r_p}{r}$$

由于是无限长的线电荷,不能将 r_p 选为无穷远点。

3.10 一点电荷 +q 位于 (-a,0,0) ,另一点电荷 -2q 位于 (a,0,0) ,求空间的零电位面。

解 两个点电荷 +q 和 -2q 在空间产生的电位

$$\varphi(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{q}{\sqrt{(x+a)^2 + y^2 + z^2}} - \frac{2q}{\sqrt{(x-a)^2 + y^2 + z^2}} \right]$$

令
$$\varphi(x,y,z) = 0$$
 ,则有
$$\frac{1}{\sqrt{(x+a)^2 + y^2 + z^2}} - \frac{2}{\sqrt{(x-a)^2 + y^2 + z^2}} = 0$$
 即
$$4[(x+a)^2 + y^2 + z^2] = (x-a)^2 + y^2 + z^2$$
 故得
$$(x + \frac{5}{3}a)^2 + y^2 + z^2 = (\frac{4}{3}a)^2$$

由此可见,零电位面是一个以点 $\left(-\frac{5}{3}a,0,0\right)$ 为球心、 $\frac{4}{3}a$ 为半径的球面。

3.11 证明习题 3.2 的电位表达式为
$$\varphi(r) = \frac{Ze}{4\pi\varepsilon_0} (\frac{1}{r} + \frac{r^2}{2r_a} - \frac{3}{2r_a})$$

解 位于球心的正电荷 Ze 在原子外产生的电通量密度为 $D_1 = e_r \frac{Ze}{4\pi r^2}$

电子云在原子外产生的电通量密度则为 $\mathbf{D}_2 = \mathbf{e}_r \frac{\rho 4\pi r_a^3/3}{4\pi r^2} = -\mathbf{e}_r \frac{Ze}{4\pi r^2}$

所以原子外的电场为零。故原子内电位为

$$\varphi(r) = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{r}^{r_a} D \, dr = \frac{Ze}{4\pi\varepsilon_0} \int_{r}^{r_a} \left(\frac{1}{r^2} - \frac{r}{r_a^3}\right) \, dr = \frac{Ze}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r} + \frac{r^2}{2r_a} - \frac{3}{2r_a}\right)$$

3.12 电场中有一半径为a的圆柱体,已知柱内外的电位函数分别为

$$\begin{cases} \varphi(r) = 0 & r \le a \\ \varphi(r) = A(r - \frac{a^2}{r})\cos\phi & r \ge a \end{cases}$$

- (1) 求圆柱内、外的电场强度;
- (2) 这个圆柱是什么材料制成的?表面有电荷分布吗?试求之。

解 (1) 由
$$\mathbf{E} = -\nabla \varphi$$
, 可得到 $r < a$ 时, $\mathbf{E} = -\nabla \varphi = 0$
$$r > a$$
 时, $\mathbf{E} = -\nabla \varphi = -\mathbf{e}_r \frac{\partial}{\partial r} [A(r - \frac{a^2}{r})\cos \phi] - \mathbf{e}_\phi \frac{\partial}{r\partial \phi} [A(r - \frac{a^2}{r})\cos \phi] = -\mathbf{e}_r A(1 + \frac{a^2}{r^2})\cos \phi + \mathbf{e}_\phi A(1 - \frac{a^2}{r^2})\sin \phi$

(2) 该圆柱体为等位体,所以是由导体制成的,其表面有电荷分布,电荷面密度为

$$\sigma = \varepsilon_0 \mathbf{n} \cdot \mathbf{E} \Big|_{r=a} = \varepsilon_0 \mathbf{e}_r \cdot \mathbf{E} \Big|_{r=a} = -2\varepsilon_0 A \cos \phi$$

- **3.13** 验证下列标量函数在它们各自的坐标系中满足 $\nabla^2 \varphi = 0$

 - (2) $r^n[\cos(n\phi) + A\sin(n\phi)]$ 圆柱坐标;
- (3) $r^{-n}\cos(n\phi)$ 圆柱坐标;
- (4) r cos *φ* 球坐标;
- (5) $r^{-2}\cos\phi$ 球坐标。

解 (1) 在直角坐标系中
$$\nabla^2 \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}$$
 $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} [\sin(kx)\sin(ly)e^{-hz}] = -k^2 \sin(kx)\sin(ly)e^{-hz}$
 $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} [\sin(kx)\sin(ly)e^{-hz}] = -l^2 \sin(kx)\sin(ly)e^{-hz}$
 $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = \frac{\partial^2}{\partial z^2} [\sin(kx)\sin(ly)e^{-hz}] = h^2 \sin(kx)\sin(ly)e^{-hz}$
 $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = \frac{\partial^2}{\partial z^2} [\sin(kx)\sin(ly)e^{-hz}] = h^2 \sin(kx)\sin(ly)e^{-hz}$
 $\nabla^2 \varphi = (-k^2 - l^2 + h^2)\sin(kx)\sin(ly)e^{-hz} = 0$

(2) 作题柱坐标系中 $\nabla^2 \varphi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \frac{\partial \varphi}{\partial r}) + \frac{\partial^2 \varphi}{r^2 \partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}$
 $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \frac{\partial \varphi}{\partial r}) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} [r \frac{\partial}{\partial r} r^n [\cos(n\phi) + A\sin(n\phi)]] + n^2 r^{n-2} [\cos(n\phi) + A\sin(n\phi)]$
 $\frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \varphi^2} = -n^2 r^{n-2} [\cos(n\phi) + A\sin(n\phi)] = 0$
 $\nabla^2 \varphi = 0$

(3) $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \frac{\partial \varphi}{\partial r}) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} [r \frac{\partial}{\partial r} [r^{-n} \cos(n\phi)]] = n^2 r^{-n-2} \cos(n\phi)$
 $\frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \varphi^2} = -n^2 r^{-n-2} \cos(n\phi)$
 $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = \frac{\partial^2}{\partial z^2} [r^n \cos(n\phi)] = 0$
 $\nabla^2 \varphi = 0$

(4) 在球坐标系中 $\nabla^2 \varphi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r}) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\sin \theta} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial \varphi}{\partial \theta}) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2}$
 $\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta}) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r \cos \theta)] = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (r \cos \theta)] = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (r \cos \theta) = 0$
 $\nabla^2 \varphi = 0$

(5)
$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r}) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} [r^2 \frac{\partial}{\partial r} (r^{-2} \cos \theta)] = \frac{2}{r^2} \cos \theta$$

$$\frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial \varphi}{\partial \theta}) = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} [\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} (r^{-2} \cos \theta)] =$$

$$\frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (-r^{-2} \sin^2 \theta) = -\frac{2}{r^4} \cos \theta$$

$$\frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2} = \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} (r^{-2} \cos \theta) = 0$$

$$\nabla^2 \varphi = 0$$

3.14 已知 y > 0 的空间中没有电荷,下列几个函数中哪些是可能的电位的解?

- (1) $e^{-y} \cosh x$;
- (2) $e^{-y} \cos x$;
- (3) $e^{-\sqrt{2}y}\cos x\sin x$
- (4) $\sin x \sin y \sin z$.

$$\mathbf{f} \qquad (1) \quad \frac{\partial^2}{\partial x^2} (e^{-y} \cosh x) + \frac{\partial^2}{\partial y^2} (e^{-y} \cosh x) + \frac{\partial^2}{\partial z^2} (e^{-y} \cosh x) = 2e^{-y} \cosh x \neq 0$$

所以函数 $e^{-y} \cosh x$ 不是 y > 0 空间中的电位的解;

(2)
$$\frac{\partial^{2}}{\partial x^{2}}(e^{-y}\cos x) + \frac{\partial^{2}}{\partial y^{2}}(e^{-y}\cos x) + \frac{\partial^{2}}{\partial z^{2}}(e^{-y}\cos x) = -e^{-y}\cos x + e^{-y}\cos x = 0$$

所以函数 $e^{-y}\cos x$ 是y>0空间中可能的电位的解;

(3)
$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} (e^{-\sqrt{2}y} \cos x \sin x) + \frac{\partial^2}{\partial y^2} (e^{-\sqrt{2}y} \cos x \sin x) + \frac{\partial^2}{\partial z^2} (e^{-\sqrt{2}y} \cos x \sin x) =$$
$$-4e^{-\sqrt{2}y} \cos x \sin x + 2e^{-\sqrt{2}y} \cos x \sin x \neq 0$$

所以函数 $e^{-\sqrt{2}y}\cos x\sin x$ 不是y>0空间中的电位的解;

(4)
$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} (\sin x \sin y \sin z) + \frac{\partial^2}{\partial y^2} (\sin x \sin y \sin z) + \frac{\partial^2}{\partial z^2} (\sin x \sin y \sin z) = -3 \sin x \sin y \sin z \neq 0$$

所以函数 $\sin x \sin y \sin z$ 不是 y > 0 空间中的电位的解。

3.15 中心位于原点,边长为L的电介质立方体的极化强度矢量为 $P = P_0(e_x x + e_y y + e_z z)$ 。
(1) 计算面束缚电荷密度和体束缚电荷密度; (2) 证明总的束缚电荷为零。

解 (1)
$$\rho_P = -\nabla \cdot \mathbf{P} = -3P_0$$

$$\sigma_P(x = \frac{L}{2}) = \mathbf{n} \cdot \mathbf{P} \Big|_{x=L/2} = \mathbf{e}_x \cdot \mathbf{P} \Big|_{x=L/2} = \frac{L}{2} P_0$$

$$\sigma_P(x = -\frac{L}{2}) = \mathbf{n} \cdot \mathbf{P} \Big|_{x=-L/2} = -\mathbf{e}_x \cdot \mathbf{P} \Big|_{x=-L/2} = \frac{L}{2} P_0$$
同理
$$\sigma_P(y = \frac{L}{2}) = \sigma_P(y = -\frac{L}{2}) = \sigma_P(z = \frac{L}{2}) = \sigma_P(z = -\frac{L}{2}) = \frac{L}{2} P_0$$

(2)
$$q_P = \int_{\tau} \rho_P d\tau + \oint_{S} \sigma_P dS = -3P_0L^3 + 6L^2 \times \frac{L}{2}P_0 = 0$$

3.16 一半径为 R_0 的介质球,介电常数为 $\mathcal{E}_r\mathcal{E}_0$,其内均匀分布自由电荷 \mathcal{P} ,证明中心点的

$$\frac{2\varepsilon_r + 1}{2\varepsilon_r} (\frac{\rho}{3\varepsilon_0}) R_0^2$$

$$\mathbf{m}$$
 由 $\oint_{S} \mathbf{D} \cdot \mathbf{d} \mathbf{S} = q$,可得到

$$r < R_0$$
 时, $4\pi r^2 D_1 = \frac{4\pi r^3}{3} \rho$

即

$$D_1 = \frac{\rho r}{3}$$
, $E_1 = \frac{D_1}{\varepsilon_r \varepsilon_0} = \frac{\rho r}{3\varepsilon_r \varepsilon_0}$

$$r > R_0 \, \mathrm{Ff} \, , \qquad \qquad 4 \pi r^2 D_2 = \frac{4 \pi R_0^3}{3} \, \rho$$

即

$$D_2 = \frac{\rho R_0^3}{3r^2} \quad , \qquad E_2 = \frac{D_1}{\varepsilon_0} = \frac{\rho R_0^3}{3\varepsilon_0 r^2}$$

故中心点的电位为

$$\varphi(0) = \int_{0}^{R_{0}} E_{1} dr + \int_{R_{0}}^{\infty} E_{2} dr = \int_{0}^{R_{0}} \frac{\rho r}{3\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}} dr + \int_{R_{0}}^{\infty} \frac{\rho R_{0}^{3}}{3\varepsilon_{0}r^{2}} dr = \frac{\rho R_{0}^{2}}{6\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}} + \frac{\rho R_{0}^{2}}{3\varepsilon_{0}} = \frac{2\varepsilon_{r} + 1}{2\varepsilon_{r}} (\frac{\rho}{3\varepsilon_{0}}) R_{0}^{2}$$

3.17 一个半径为R的介质球,介电常数为 ε ,球内的极化强度 $P = e_r K/r$,其中K为一 常数。(1) 计算束缚电荷体密度和面密度;(2) 计算自由电荷密度;(3)计算球内、外的电场 和电位分布。

介质球内的束缚电荷体密度为

$$\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P} = -\frac{1}{r^2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} (r^2 \frac{K}{r}) = -\frac{K}{r^2}$$

在r=R的球面上,束缚电荷面密度为

$$\sigma_p = \mathbf{n} \cdot \mathbf{P}\big|_{r=R} = \mathbf{e}_r \cdot \mathbf{P}\big|_{r=R} = \frac{K}{R}$$

(2) 由于
$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$
, 所以

(2) 由于
$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$
, 所以
$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} + \nabla \cdot \mathbf{P} = \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon} \nabla \cdot \mathbf{D} + \nabla \cdot \mathbf{P}$$

即

$$(1 - \frac{\mathcal{E}_0}{\mathcal{E}}) \nabla \cdot \boldsymbol{D} = \nabla \cdot \boldsymbol{P}$$

由此可得到介质球内的自由电荷体密度为 $\rho = \nabla \cdot \boldsymbol{D} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon - \varepsilon_0} \nabla \cdot \boldsymbol{P} = -\frac{\varepsilon}{\varepsilon - \varepsilon_0} \rho_p = \frac{\varepsilon K}{(\varepsilon - \varepsilon_0)r^2}$

 $q = \int \rho d\tau = \frac{\varepsilon K}{\varepsilon - \varepsilon_0} \int_0^{\kappa} \frac{1}{r^2} 4\pi r^2 dr = \frac{4\pi \varepsilon RK}{\varepsilon - \varepsilon_0}$ 总的自由电荷量

(3) 介质球内、外的电场强度分别为

$$\boldsymbol{E}_{1} = \frac{\boldsymbol{P}}{\varepsilon - \varepsilon_{0}} = \boldsymbol{e}_{r} \frac{K}{(\varepsilon - \varepsilon_{0})r}$$
 $(r < R)$

$$\boldsymbol{E}_{2} = \boldsymbol{e}_{r} \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}} = \boldsymbol{e}_{r} \frac{\varepsilon RK}{\varepsilon_{0}(\varepsilon - \varepsilon_{0})r^{2}} \qquad (r > R)$$

介质球内、外的电位分别为

$$\varphi_{1} = \int_{r}^{\infty} \boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{I} = \int_{r}^{R} E_{1} dr + \int_{R}^{\infty} E_{2} dr =
\int_{r}^{R} \frac{K}{(\varepsilon - \varepsilon_{0})r} dr + \int_{R}^{\infty} \frac{\varepsilon RK}{\varepsilon_{0}(\varepsilon - \varepsilon_{0})r^{2}} dr =
\frac{K}{(\varepsilon - \varepsilon_{0})} \ln \frac{R}{r} + \frac{\varepsilon}{\varepsilon_{0}(\varepsilon - \varepsilon_{0})} \qquad (r \le R)
\varphi_{2} = \int_{r}^{\infty} E_{2} dr = \int_{r}^{\infty} \frac{\varepsilon RK}{\varepsilon_{0}(\varepsilon - \varepsilon_{0})r^{2}} dr = \frac{\varepsilon RK}{\varepsilon_{0}(\varepsilon - \varepsilon_{0})r} \qquad (r \ge R)$$

3.18 (1) 证明不均匀电介质在没有自由电荷密度时可能存在束缚电荷体密度; (2) 导出束缚电荷密度 ρ_P 的表达式。

解 (1) 由
$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$
,得束缚电荷体密度为 $\rho_P = -\nabla \cdot \mathbf{P} = -\nabla \cdot \mathbf{D} + \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}$ 在介质内没有自由电荷密度时, $\nabla \cdot \mathbf{D} = 0$,则有 $\rho_P = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}$ 由于 $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$,有 $\nabla \cdot \mathbf{D} = \nabla \cdot (\varepsilon \mathbf{E}) = \varepsilon \nabla \cdot \mathbf{E} + \mathbf{E} \cdot \nabla \varepsilon = 0$ 所以
$$\nabla \cdot \mathbf{E} = -\frac{\mathbf{E} \cdot \nabla \varepsilon}{\varepsilon}$$

由此可见,当电介质不均匀时, $\nabla \cdot \mathbf{E}$ 可能不为零,故在不均匀电介质中可能存在束缚电荷体密度。

(2) 束缚电荷密度
$$\rho_P$$
 的表达式为
$$\rho_P = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} = -\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon} \mathbf{E} \cdot \nabla \varepsilon$$

3.19 两种电介质的相对介电常数分别为 ε_{r1} =2 和 ε_{r2} =3,其分界面为z=0 平面。如果已知介质 1 中的电场的

$$E_1 = e_x 2y - e_y 3x + e_z (5+z)$$

那么对于介质 2 中的 E_2 和 D_2 ,我们可得到什么结果?能否求出介质 2 中任意点的 E_2 和 D_2 ? 解 设在介质 2 中

$$m{E}_{2}(x,y,0) = m{e}_{x}E_{2x}(x,y,0) + m{e}_{y}E_{2y}(x,y,0) + m{e}_{z}E_{2z}(x,y,0)$$
 $m{D}_{2} = m{\varepsilon}_{0}m{\varepsilon}_{r2}m{E}_{2} = 3m{\varepsilon}_{0}m{E}_{2}$
在 $z = 0$ 处,由 $m{e}_{z} \times (m{E}_{1} - m{E}_{2}) = 0$ 和 $m{e}_{z} \cdot (m{D}_{1} - m{D}_{2}) = 0$,可得
$$\left\{ m{e}_{x}2y - m{e}_{y}3x = m{e}_{x}E_{2x}(x,y,0) + m{e}_{y}E_{2y}(x,y,0) \right.$$

$$\left\{ 2 \times 5m{\varepsilon}_{0} = 3m{\varepsilon}_{0}E_{2z}(x,y,0) \right.$$
于是得到
$$E_{2x}(x,y,0) = 2y$$

$$E_{2x}(x,y,0) = -3x$$

$$E_{2y}(x, y, 0) = -3x$$

 $E_{2z}(x, y, 0) = 10/3$

$$E_2(x, y, 0) = e_x 2y - e_y 3x + e_z (10/3)$$

故得到介质 2 中的 E_2 和 D_2 在 z=0 处的表达式分别为

$$\boldsymbol{D}_{2}(x, y, 0) = \varepsilon_{0}(\boldsymbol{e}_{x}6y - \boldsymbol{e}_{y}9x + \boldsymbol{e}_{z}10)$$

不能求出介质 2 中任意点的 E_2 和 D_2 。由于是非均匀场,介质中任意点的电场与边界面上的 电场是不相同的。

3.20 电场中一半径为a、介电常数为 ε 的介质球,已知球内、外的电位函数分别为

$$\varphi_{1} = -E_{0}r\cos\theta + \frac{\varepsilon - \varepsilon_{0}}{\varepsilon + 2\varepsilon_{0}}a^{3}E_{0}\frac{\cos\theta}{r^{2}} \qquad r \ge a$$

$$\varphi_{2} = -\frac{3\varepsilon_{0}}{\varepsilon + 2\varepsilon_{0}}E_{0}r\cos\theta \qquad r \le a$$

验证球表面的边界条件,并计算球表面的束缚电荷密度。

解 在球表面上

$$\varphi_{1}(a,\theta) = -E_{0}a\cos\theta + \frac{\varepsilon - \varepsilon_{0}}{\varepsilon + 2\varepsilon_{0}}aE_{0}\cos\theta = -\frac{3\varepsilon_{0}}{\varepsilon + 2\varepsilon_{0}}E_{0}a\cos\theta$$

$$\varphi_{2}(a,\theta) = -\frac{3\varepsilon_{0}}{\varepsilon + 2\varepsilon_{0}}E_{0}a\cos\theta$$

$$\frac{\partial\varphi_{1}}{\partial r}\Big|_{r=a} = -E_{0}\cos\theta - \frac{2(\varepsilon - \varepsilon_{0})}{\varepsilon + 2\varepsilon_{0}}E_{0}\cos\theta = -\frac{3\varepsilon}{\varepsilon + 2\varepsilon_{0}}E_{0}\cos\theta$$

$$\frac{\partial\varphi_{2}}{\partial r}\Big|_{r=a} = -\frac{3\varepsilon_{0}}{\varepsilon + 2\varepsilon_{0}}E_{0}\cos\theta$$

$$\varphi_{1}(a,\theta) = \varphi_{2}(a,\theta), \qquad \varepsilon_{0}\frac{\partial\varphi_{1}}{\partial r}\Big|_{r=a} = \varepsilon\frac{\partial\varphi_{2}}{\partial r}\Big|_{r=a}$$

故有

可见 φ_1 和 φ_2 满足球表面上的边界条件。

球表面的束缚电荷密度为

$$\sigma_{p} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{P}_{2} \Big|_{r=a} = (\varepsilon - \varepsilon_{0}) \mathbf{e}_{r} \cdot \mathbf{E}_{2} = -(\varepsilon - \varepsilon_{0}) \frac{\partial \varphi_{2}}{\partial r} \Big|_{r=a} = \frac{3\varepsilon_{0}(\varepsilon - \varepsilon_{0})}{\varepsilon + 2\varepsilon_{0}} E_{0} \cos \theta$$

- 平行板电容器的长、宽分别为a和b,极板间距离为d。电容器的一半厚度 $(0 \sim \frac{d}{2})$ 用介电常数为 ε 的电介质填充,如题 3.21 图所示。
 - (1) (1) 板上外加电压 U_0 , 求板上的自由电荷面密度、束缚电荷;
 - (2) (2) 若已知板上的自由电荷总量为Q,求此时极板间电压和束缚电荷;
 - (3)(3) 求电容器的电容量。

解 (1) 设介质中的电场为 $E = e_z E$, 空气中的电场为 $E_0 = e_z E_0$ 。由 $D = D_0$, 有

$$\begin{split} \varepsilon E &= \varepsilon_0 E_0 \\ E \frac{d}{2} + E_0 \frac{d}{2} &= -U_0 \\ \frac{d}{d} , \quad E_0 &= -\frac{2\varepsilon U_0}{(\varepsilon + \varepsilon_0)d} \end{split}$$

又由于

由以上两式解得

$$E = -\frac{2\varepsilon_0 U_0}{(\varepsilon + \varepsilon_0)d} , \quad E_0 = -\frac{2\varepsilon U_0}{(\varepsilon + \varepsilon_0)d}$$

题 3.21 图

故下极板的自由电荷面密度为
$$\sigma_{\mathbb{T}} = \varepsilon E = -\frac{2\varepsilon_0 \varepsilon U_0}{(\varepsilon + \varepsilon_0)d}$$

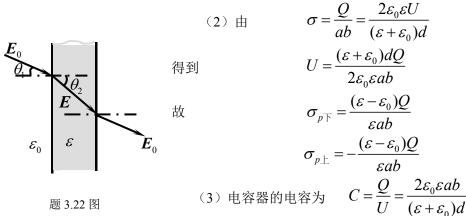
上极板的自由电荷面密度为
$$\sigma_{\perp} = -\varepsilon_0 E_0 = \frac{2\varepsilon_0 \varepsilon U_0}{(\varepsilon + \varepsilon_0)d}$$

电介质中的极化强度
$$\mathbf{P} = (\varepsilon - \varepsilon_0)\mathbf{E} = -\mathbf{e}_z \frac{2\varepsilon_0(\varepsilon - \varepsilon_0)U_0}{(\varepsilon + \varepsilon_0)d}$$

故下表面上的束缚电荷面密度为
$$\sigma_{pr} = -\boldsymbol{e}_z \cdot \boldsymbol{P} = \frac{2\varepsilon_0(\varepsilon - \varepsilon_0)U_0}{(\varepsilon + \varepsilon_0)d}$$

上表面上的束缚电荷面密度为

$$\sigma_{p\perp} = \boldsymbol{e}_z \cdot \boldsymbol{P} = -\frac{2\varepsilon_0(\varepsilon - \varepsilon_0)U_0}{(\varepsilon + \varepsilon_0)d}$$



3.22 厚度为t、介电常数为 $\varepsilon = 4\varepsilon_0$ 的无限大介质板,放置于均匀电场 E_0 中,板与 E_0 成角 θ_1 , 如题 3.22 图所示。求: (1) 使 $\theta_2 = \pi/4$ 的 θ_1 值; (2) 介质板两表面的极化电荷密度。

(1) 根据静电场的边界条件,在介质板的表面上有 $\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta} = \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}$

 $\theta_1 = \tan^{-1} \frac{\varepsilon_0 \tan \theta_2}{\varepsilon_0} = \tan^{-1} \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_0} = \tan^{-1} \frac{1}{4} = 14^\circ$ 由此得到

(2) 设介质板中的电场为E,根据分界面上的边界条件,有 $\varepsilon_0 E_{0n} = \varepsilon E_n$,即 $\varepsilon_0 E_0 \cos \theta_1 = \varepsilon E_n$

所以
$$E_n = \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon} E_0 \cos \theta_1 = \frac{1}{4} E_0 \cos 14^\circ$$

 $\sigma_p = -(\varepsilon - \varepsilon_0)E_n = -\frac{3}{4}\varepsilon_0 E_0 \cos 14^\circ = -0.728\varepsilon_0 E_0$ 介质板左表面的束缚电荷面密度 $\sigma_p = (\varepsilon - \varepsilon_0)E_n = \frac{3}{4}\varepsilon_0 E_0 \cos 14^\circ = 0.728\varepsilon_0 E_0$ 介质板右表面的束缚电荷面密度

- 在介电常数为 ε 的无限大均匀介质中,开有如下的空腔,求各腔中的 E_0 和 D_0 :
- (1) 平行于E的针形空腔;
- (2) 底面垂直于E的薄盘形空腔:

- (3) 小球形空腔(见第四章 4.14 题)。
- **解** (1) 对于平行于 \boldsymbol{E} 的针形空腔,根据边界条件,在空腔的侧面上,有 $\boldsymbol{E}_0 = \boldsymbol{E}$ 。故在针形空腔中

$$\boldsymbol{E}_0 = \boldsymbol{E}$$
, $\boldsymbol{D}_0 = \boldsymbol{\varepsilon}_0 \boldsymbol{E}_0 = \boldsymbol{\varepsilon}_0 \boldsymbol{E}$

(2) 对于底面垂直于 \boldsymbol{E} 的薄盘形空腔,根据边界条件,在空腔的底面上,有 $\boldsymbol{D}_0 = \boldsymbol{D}$ 。故在薄盘形空腔中

$$\boldsymbol{D}_0 = \boldsymbol{D} = \boldsymbol{\varepsilon} \boldsymbol{E}$$
, $\boldsymbol{E}_0 = \frac{\boldsymbol{D}_0}{\boldsymbol{\varepsilon}_0} = \frac{\boldsymbol{\varepsilon} \boldsymbol{E}}{\boldsymbol{\varepsilon}_0}$

3.24 在面积为 S 的平行板电容器内填充介电常数作线性变化的介质,从一极板 (y=0) 处的 ε_1 一直变化到另一极板 (y=d) 处的 ε_2 ,试求电容量。

解 由题意可知,介质的介电常数为 $\varepsilon = \varepsilon_1 + y(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)/d$ 设平行板电容器的极板上带电量分别为 $\pm q$,由高斯定理可得

$$\begin{split} D_y &= \sigma = \frac{q}{S} \\ E_y &= \frac{D_y}{\varepsilon} = \frac{q}{\left[\varepsilon_1 + y(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)/d\right]S} \\ \mathring{\Box} \not \succeq \qquad U &= \int_0^d E_y \, \mathrm{d} \, y = \int_0^d \frac{q}{\left[\varepsilon_1 + y(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)/d\right]S} \, \mathrm{d} \, y = \frac{qd}{S(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)} \ln \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \\ C &= \frac{q}{U} = \frac{S(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}{d \ln(\varepsilon_2/\varepsilon_1)} \end{split}$$

故电容量为

所以,两极板的电位差

3.25 一体密度为 $\rho = 2.32 \times 10^{-7} \, \text{C/m}^3$ 的质子束,束内的电荷均匀分布,束直径为 $2 \, \text{mm}$,束外没有电荷分布,试计算质子束内部和外部的径向电场强度。

解 在质子束内部,由高斯定理可得 $2\pi r E_r = \frac{1}{\varepsilon_0}\pi r^2 \rho$

故

$$E_r = \frac{\rho r}{2\varepsilon_0} = \frac{2.32 \times 10^{-7} r}{2 \times 8.854 \times 10^{-12}} = 1.31 \times 10^4 r \quad \text{V/m} \qquad (r < 10^{-3} \text{ m})$$

在质子束外部,有 $2\pi r E_r = \frac{1}{\varepsilon_0} \pi a^2 \rho$

故
$$E_r = \frac{\rho a^2}{2\varepsilon_0 r} = \frac{2.32 \times 10^{-7} \times 10^{-6}}{2 \times 8.854 \times 10^{-12} r} = 1.31 \times 10^{-2} \frac{1}{r} \quad \text{V/m} \qquad (r > 10^{-3} \text{ m})$$

3.26 考虑一块电导率不为零的电介质 (γ, ε) ,设其介质特性和导电特性都是不均匀的。证明当介质中有恒定电流 J 时,体积内将出现自由电荷,体密度为 $\rho = J \cdot \nabla(\varepsilon/\gamma)$ 。试问有没有束缚体电荷 ρ_P ? 若有则进一步求出 ρ_P 。

$$\boldsymbol{\beta} = \nabla \cdot \boldsymbol{D} = \nabla \cdot (\varepsilon \boldsymbol{E}) = \nabla \cdot (\frac{\varepsilon}{\gamma} \boldsymbol{J}) = \boldsymbol{J} \cdot \nabla (\frac{\varepsilon}{\gamma}) + \frac{\varepsilon}{\gamma} \nabla \cdot \boldsymbol{J}$$

对于恒定电流,有 $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$,故得到 $\rho = \mathbf{J} \cdot \nabla (\varepsilon/\gamma)$

介质中有束缚体电荷 ρ_P ,且

$$\rho_{P} = -\nabla \bullet \boldsymbol{P} = -\nabla \bullet \boldsymbol{D} + \boldsymbol{\varepsilon}_{0} \nabla \bullet \boldsymbol{E} = -\boldsymbol{J} \bullet \nabla (\frac{\boldsymbol{\varepsilon}}{\gamma}) + \boldsymbol{\varepsilon}_{0} \nabla \bullet (\frac{\boldsymbol{J}}{\gamma}) = -\boldsymbol{J} \bullet \nabla (\frac{\boldsymbol{\varepsilon}}{\gamma}) + \boldsymbol{J} \bullet \nabla (\frac{\boldsymbol{\varepsilon}_{0}}{\gamma}) = -\boldsymbol{J} \bullet \nabla (\frac{\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}_{0}}{\gamma}) = -\boldsymbol{J} \bullet \nabla (\frac{\boldsymbol$$

3.27 填充有两层介质的同轴电缆,内导体半径为a,外导体内半径为c,介质的分界面半 径为b。两层介质的介电常数为 ε_1 和 ε_2 ,电导率为 γ_1 和 γ_2 。设内导体的电压为 U_0 ,外导体接地。 求:(1)两导体之间的电流密度和电场强度分布;(2)介质分界面上的自由电荷面密度;(3)同 轴线单位长度的电容及漏电阻。

解(1)设同轴电缆中单位长度的径向电流为I,则由 $\int J \cdot dS = I$,可得电流密度

$$egin{aligned} oldsymbol{J} &= oldsymbol{e}_r rac{I}{2\pi r} & (a < r < c) \ egin{aligned} heta &= oldsymbol{e}_r rac{I}{2\pi r \gamma_1} & (a < r < b) \ oldsymbol{E}_1 &= rac{oldsymbol{J}}{\gamma_1} &= oldsymbol{e}_r rac{I}{2\pi r \gamma_2} & (b < r < c) \ \\ heta &= oldsymbol{J} &= oldsymbol{e}_1 \cdot oldsymbol{e}_1 \cdot oldsymbol{e}_1 \cdot oldsymbol{e}_2 \cdot oldsymbol{e}_r \cdot o$$

干是得到

故两种介质中的电流密度和电场强度分别为

$$J = e_r \frac{\gamma_1 \gamma_2 U_0}{r[\gamma_2 \ln(b/a) + \gamma_1 \ln(c/b)]} \qquad (a < r < c)$$

$$E_1 = e_r \frac{\gamma_2 U_0}{r[\gamma_2 \ln(b/a) + \gamma_1 \ln(c/b)]} \qquad (a < r < b)$$

$$E_2 = e_r \frac{\gamma_1 U_0}{r[\gamma_2 \ln(b/a) + \gamma_1 \ln(c/b)]} \qquad (b < r < c)$$

$$\boldsymbol{E}_{2} = \boldsymbol{e}_{r} \frac{\gamma_{1} U_{0}}{r[\gamma_{2} \ln(b/a) + \gamma_{1} \ln(c/b)]} \qquad (b < r < c)$$

(2) 由 $\sigma = \mathbf{n} \cdot \mathbf{D}$ 可得,介质 1 内表面的电荷面密度为

$$\sigma_1 = \varepsilon_1 \boldsymbol{e}_r \cdot \boldsymbol{E}_1 \Big|_{r=a} = \frac{\varepsilon_1 \gamma_2 U_0}{a[\gamma_2 \ln(b/a) + \gamma_1 \ln(c/b)]}$$

介质 2 外表面的电荷面密度为

$$\sigma_2 = -\varepsilon_2 \mathbf{e}_r \cdot \mathbf{E}_2 \Big|_{r=c} = -\frac{\varepsilon_2 \gamma_1 U_0}{c[\gamma_2 \ln(b/a) + \gamma_1 \ln(c/b)]}$$

两种介质分界面上的电荷面密度为

$$\sigma_{12} = -(\varepsilon_1 \boldsymbol{e}_r \bullet \boldsymbol{E}_1 - \varepsilon_2 \boldsymbol{e}_r \bullet \boldsymbol{E}_2) \Big|_{r=b} = -\frac{(\varepsilon_1 \gamma_2 - \varepsilon_2 \gamma_1) U_0}{b[\gamma_2 \ln(b/a) + \gamma_1 \ln(c/b)]}$$
(3) 同轴线单位长度的漏电阻为
$$R = \frac{U_0}{I} = \frac{\gamma_2 \ln(b/a) + \gamma_1 \ln(c/b)}{2\pi \gamma_1 \gamma_2}$$
由静电比拟,可得同轴线单位长度的电容为
$$C = \frac{2\pi \varepsilon_1 \varepsilon_2}{\varepsilon_2 \ln(b/a) + \varepsilon_1 \ln(c/b)}$$

3.28 半径为 R_1 和 R_2 (R_1 < R_2)的两个同心的理想导体球面间充满了介电常数为 ε 、电导 率为 $\gamma = \gamma_0 (1 + K/r)$ 的导电媒质(K为常数)。若内导体球面的电位为 U_0 , 外导体球面接地。试 求:(1)媒质中的电荷分布;(2)两个理想导体球面间的电阻。

 \mathbf{M} 设由内导体流向外导体的电流为I,由于电流密度成球对称分布,所以

$$\boldsymbol{J} = \boldsymbol{e}_r \frac{I}{4\pi r^2} \qquad (R_1 < r < R_2)$$
 电场强度
$$\boldsymbol{E} = \frac{\boldsymbol{J}}{\gamma} = \boldsymbol{e}_r \frac{I}{4\pi \gamma_0 (r+K)r} \qquad (R_1 < r < R_2)$$
 由两导体间的电压
$$U_0 = \int\limits_{R_1}^{R_2} \boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{r} = \int\limits_{R_1}^{R_2} \frac{I}{4\pi \gamma_0 (r+K)r} dr = \frac{I}{4\pi \gamma_0 K} \ln \left[\frac{R_2 (R_1 + K)}{R_1 (R_2 + K)} \right]$$

可得到

电场强度

$$I = \frac{4\pi\gamma_0 K U_0}{\ln\left[\frac{R_2(R_1 + K)}{R_1(R_2 + K)}\right]}$$

所以

$$\boldsymbol{J} = \boldsymbol{e}_r \frac{\gamma_0 K U_0}{r^2 \ln \left[\frac{R_2 (R_1 + K)}{R_1 (R_2 + K)} \right]}$$

媒质中的电荷体密度为

$$\rho = \boldsymbol{J} \bullet \nabla (\frac{\varepsilon}{\gamma}) = \frac{\varepsilon K^2 U_0}{\ln \left[\frac{R_2 (R_1 + K)}{R_1 (R_2 + K)} \right]} \frac{1}{(r + K)^2 r^2}$$

媒质内、外表面上的电荷面密度分别为

$$\sigma_{1} = \frac{\varepsilon}{\gamma} \boldsymbol{e}_{r} \cdot \boldsymbol{J} \Big|_{r=R_{1}} = \frac{\varepsilon K U_{0}}{\ln \left[\frac{R_{2}(R_{1} + K)}{R_{1}(R_{2} + K)} \right]} \frac{1}{(R_{1} + K)R_{1}}$$

$$\sigma_{2} = -\frac{\varepsilon}{\gamma} \boldsymbol{e}_{r} \cdot \boldsymbol{J} \Big|_{r=R_{2}} = -\frac{\varepsilon K U_{0}}{\ln \left[\frac{R_{2}(R_{1} + K)}{R_{1}(R_{2} + K)} \right]} \frac{1}{(R_{2} + K)R_{2}}$$

(2) 两理想导体球面间的电阻

$$R = \frac{U_0}{I} = \frac{1}{4\pi\gamma_0 K} \ln \frac{R_2(R_1 + K)}{R_1(R_2 + K)}$$

- **3.29** 电导率为 γ 的无界均匀电介质内,有两个半径分别为 R_1 和 R_2 的理想导体小球,两球 之间的距离为 $d(d >> R_1, d >> R_2)$, 试求两小导体球面间的电阻。
- 解 此题可采用静电比拟的方法求解。假设两小球分别带电荷q和-q,由于两球间的距离 $d \gg R_1$ 、 $d \gg R_2$, 可近似认为小球上的电荷均匀分布在球面上。由电荷q和-q的电位叠加 求出两小球表面的电位差,即可求得两小导体球面间的电容,再由静电比拟求出两小导体球面间 的电阻。

设两小球分别带电荷q和-q,由于 $d>> R_1$ 、 $d>> R_2$,可得到两小球表面的电位为

$$\varphi_1 = \frac{q}{4\pi\varepsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{d - R_2} \right)$$

$$\varphi_2 = -\frac{q}{4\pi\varepsilon} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{d - R_1} \right)$$

所以两小导体球面间的电容为

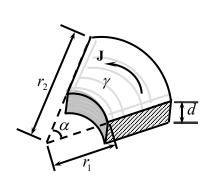
$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{4\pi\varepsilon}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} - \frac{1}{d - R_1} - \frac{1}{d - R_2}}$$

由静电比拟,得到两小导体球面间的电导为
$$G = \frac{I}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{4\pi\gamma}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} - \frac{1}{d - R_1} - \frac{1}{d - R_2}}$$

 $R = \frac{1}{G} = \frac{1}{4\pi\nu} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} - \frac{1}{d - R_1} - \frac{1}{d - R_2} \right)$ 故两个小导体球面间的电阻为

3.30 在一块厚度 d 的导电板上, 由两个半径为 r_1 和 r_2 的圆弧和夹角为 α 的两半径割出的 一块扇形体, 如题 3.30 图所示。求:(1) 沿厚度方向的电阻:(2) 两圆弧面之间的电阻: 沿lpha 方 向的两电极的电阻。设导电板的电导率为7。

解 (1) 设沿厚度方向的两电极的电压为 U_1 ,则有



题 3.30 图

$$E_1 = \frac{U_1}{d}$$

$$J_1 = \gamma E_1 = \frac{\gamma U_1}{d}$$

$$I_1 = J_1 S_1 = \frac{\gamma U_1}{d} \cdot \frac{\alpha}{2} (r_2^2 - r_1^2)$$

故得到沿厚度方向的电阻为

$$R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{2d}{\alpha \gamma (r_2^2 - r_1^2)}$$

(2) 设内外两圆弧面电极之间的电流为 I_2 ,则

$$J_2 = \frac{I_2}{S_2} = \frac{I_2}{\alpha r d} \qquad E_2 = \frac{J_2}{\gamma} = \frac{I_2}{\gamma \alpha r d}$$

$$U_2 = \int_{r_1}^{r_2} E_2 dr = \frac{I_2}{\gamma \alpha d} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

故得到两圆弧面之间的电阻为

$$R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{1}{\gamma \alpha d} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

(3) 设沿 α 方向的两电极的电压为 U_3 , 则有 $U_3 = \int_0^{\pi} E_3 r d\phi$

由于 E_3 与 ϕ 无关,所以得到

$$\mathbf{E}_{3} = \mathbf{e}_{\phi} \frac{U_{3}}{\alpha r}$$

$$\mathbf{J}_{3} = \gamma \mathbf{E}_{3} = \mathbf{e}_{\phi} \frac{\gamma U_{3}}{\alpha r}$$

$$I_{3} = \int_{S_{3}} \mathbf{J}_{3} \cdot \mathbf{e}_{\phi} dS = \int_{r_{1}}^{r_{2}} \frac{\gamma dU_{3}}{\alpha r} dr = \frac{\gamma dU_{3}}{\alpha} \ln \frac{r_{2}}{r_{1}}$$

$$\mathbf{E}_{3} = \frac{U_{3}}{r_{1}} = \frac{\alpha}{r_{2}}$$

$$\mathbf{E}_{4} = \frac{U_{3}}{r_{1}} = \frac{\alpha}{r_{2}}$$

故得到沿 α 方向的电阻为 $R_3 = \frac{U_3}{I} = \frac{\alpha}{v d \ln(r_c/r_c)}$

3.31 圆柱形电容器外导体内半径为b,内导体半径为a。当外加电压U 固定时,在b一定 的条件下,求使电容器中的最大电场强度取极小值 E_{\min} 的内导体半径 a 的值和这个 E_{\min} 的值。

解 设内导体单位长度带电荷为 ρ_l ,由高斯定理可求得圆柱形电容器中的电场强度为

$$E(r) = \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0 r}$$
 由内外导体间的电压
$$U = \int_a^b E dr = \int_a^b \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0 r} dr = \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{b}{a}$$

 $\rho_l = \frac{2\pi\varepsilon_0 U}{\ln(h/a)}$

由此得到圆柱形电容器中的电场强度与电压的关系式

$$E(r) = \frac{U}{r \ln(b/a)}$$

在圆柱形电容器中,r=a处的电场强度最大

$$E(a) = \frac{U}{a \ln(b/a)}$$

令
$$E(a)$$
 对 a 的导数为零,即
$$\frac{\partial E(a)}{\partial a} = -\frac{1}{a^2} \frac{\ln(b/a) - 1}{\ln^2(b/a)} = 0$$

由此得到 $\ln(b/a) = 1$

$$a = \frac{b}{a} \approx \frac{b}{2.718}$$

故有

$$E_{\min} = \frac{e}{h}U = 2.718 \frac{U}{h}$$

3.32 证明: 同轴线单位长度的静电储能 W_e 等于 $\frac{q_l^2}{2C}$ 。 q_l 为单位长度上的电荷量,C为单 位长度上的电容。

 $E(r) = \frac{q_l}{2\pi cr}$ 由高斯定理可求得圆柱形电容器中的电场强度为 内外导体间的电压为

$$U = \int_{a}^{b} E dr = \int_{a}^{b} \frac{\rho_{l}}{2\pi\varepsilon r} dr = \frac{\rho_{l}}{2\pi\varepsilon} \ln \frac{b}{a}$$

$$C = \frac{q_l}{U} = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}$$

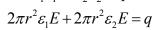
同轴线单位长度的静电储能为 $W_e = \frac{1}{2} \int_{\tau} \varepsilon E^2 d\tau = \frac{1}{2} \int_{a}^{b} \varepsilon \left(\frac{q_l}{2\pi\varepsilon r}\right)^2 2\pi r dr = \frac{1}{2} \frac{q_l^2}{2\pi\varepsilon} \ln(b/a) = \frac{1}{2} \frac{q_l^2}{C}$

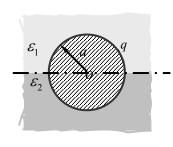
3.33 如题 3.33 图所示,一半径为a、带电量q 的导体球,其球心位于两种介质的分界面上,此两种介质的电容率分别为 ε_1 和 ε_2 ,分界面为无限大平面。求:(1)导体球的电容;(2) 总的静电能量。

解 (1) 由于电场沿径向分布,根据边界条件,在两种介质的分界面上 $E_{1t}=E_{2t}$,故有 $E_1=E_2=E$ 。由于 $D_1=\varepsilon_1E_1$ 、 $D_2=\varepsilon_2E_2$,所以 $D_1\neq D_2$ 。由高斯定理,得到

$$D_1S_1 + D_2S_2 = q$$

即





题 3.33 图

所以 $E = \frac{q}{2\pi r^2 (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)}$

导体球的电位

$$\varphi(a) = \int_{a}^{\infty} E \, dr = \frac{q}{2\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \int_{a}^{\infty} \frac{1}{r^2} \, dr = \frac{q}{2\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)a}$$

故导体球的电容 $C = \frac{q}{\varphi(a)} = 2\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)a$

(2) 总的静电能量为
$$W_e = \frac{1}{2}q\varphi(a) = \frac{q^2}{4\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)a}$$

3.34 把一带电量q、半径为a的导体球切成两半,求两半球之间的电场力。

解 先利用虚位移法求出导体球表面上单位面积的电荷受到的静电力 f ,然后在半球面上对 f 积分,求出两半球之间的电场力。

导体球的电容为 $C = 4\pi\varepsilon_0 a$

故静电能量为 $W_e = \frac{q^2}{2C} = \frac{q^2}{8\pi\epsilon a}$

根据虚位移法,导体球表面上单位面积的电荷受到的静电力

$$f = -\frac{1}{4\pi a^2} \frac{\partial W_e}{\partial a} = -\frac{1}{4\pi a^2} \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{q^2}{8\pi \varepsilon_e a} \right) = \frac{q^2}{32\pi^2 \varepsilon_e a^4}$$

方向沿导体球表面的外法向,即 $\mathbf{f} = \mathbf{e}_r f = \frac{q^2}{32\pi^2 \varepsilon_o a^4} \mathbf{e}_r$

这里 $\mathbf{e}_r = \mathbf{e}_x \sin \theta \cos \phi + \mathbf{e}_y \sin \theta \sin \phi + \mathbf{e}_z \cos \theta$

在半球面上对f积分,即得到两半球之间的静电力为

$$\boldsymbol{F} = \int \boldsymbol{f} dS = \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{\pi/2} \boldsymbol{e}_{r} \frac{q^{2}}{32\pi^{2} \varepsilon_{0} a^{4}} a^{2} \sin\theta d\theta d\phi = \boldsymbol{e}_{z} \frac{2\pi a^{2} q^{2}}{32\pi^{2} \varepsilon_{0} a^{4}} \int_{0}^{\pi/2} \cos\theta \sin\theta d\theta = \frac{q^{2}}{32\pi \varepsilon_{0} a^{2}} \boldsymbol{e}_{z}$$

3.35 如题 3.35 图所示,两平行的金属板,板间距离为d,竖直地插入在电容率为 ε 的液

体中,两板间加电压U,证明液面升高

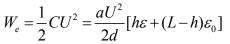
$$h = \frac{1}{2\rho g} (\varepsilon - \varepsilon_0) (\frac{U}{d})^2$$

其中 ρ 为液体的质量密度。

解 设金属板的宽度为a、高度为L。当金属板间的液面升高为h时,其电容为

$$C = \frac{\varepsilon ah}{d} + \frac{\varepsilon_0 a(L - h)}{d}$$

金属板间的静电能量为



液体受到竖直向上的静电力为

$$F_e = \frac{\partial W_e}{\partial h} = \frac{aU^2}{2d} (\varepsilon - \varepsilon_0)$$

而液体所受重力

$$F_g = mg = ahd \rho g$$

$$F_e$$
与 F_g 相平衡,即 $\frac{aU^2}{2d}(\varepsilon - \varepsilon_0) = ahdg$

故得到液面上升的高度

$$h = \frac{(\varepsilon - \varepsilon_0)U^2}{2d^2\rho g} = \frac{1}{2\rho g} (\varepsilon - \varepsilon_0)(\frac{U}{d})^2$$

3.36 可变空气电容器,当动片由 0° 至 180° 电容量由25至350pF直线地变化,当动片为 θ 角时,求作用于动片上的力矩。设动片与定片间的电压为 $U_0 = 400$ V。

解 当动片为 θ 角时, 电容器的电容为

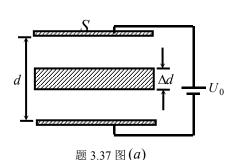
题 3.35 图

$$C_{\theta} = 25 + \frac{350 - 25}{180^{\circ}}\theta = 25 + 1.81\theta \ PF = (25 + 1.81\theta) \times 10^{-12} \ F$$

此时电容器中的静电能量为 $W_e = \frac{1}{2}C_\theta U_0^2 = \frac{1}{2}(25+1.81\theta) \times 10^{-12}U_0^2$

作用于动片上的力矩为 $T = \frac{\partial W_e}{\partial \theta} = \frac{1}{2} \times 1.81 \times 10^{-12} U_0^2 = 1.45 \times 10^{-7} Nm$

- **3.37** 平行板电容器的电容是 $\varepsilon_0 S/d$, 其中 S 是板的面积, d 为间距,忽略边缘效应。
- (1) 如果把一块厚度为 Δd 的不带电金属插入两极板之间,但不与两极接触,如题 3.37(a)图所示。则在原电容器电压 U_0 一定的条件下,电容器的能量如何变化?电容量如何变化?



(2) 如果在电荷q一定的条件下,将一块横截面为 ΔS 、介电常数为 ϵ 的电介质片插入电容器(与电容器极板面积基本上垂直地插入,如题 3.37(b) 图所示,则电容器的能量如何变化? 电容量又如何变化?

 \mathbf{M} (1)在电压 U_0 一定的条件下,未插入金属板前,极板间的电场为

$$E_0 = \frac{U_0}{d}$$

电容为
$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

静电能量为
$$W_{e0} = \frac{1}{2}C_0U_0^2 = \frac{\varepsilon_0 S U_0^2}{2d}$$

当插入金属板后, 电容器中的电场为

$$E = \frac{U_0}{d - \Delta d}$$

此时静电能量和电容分别为

$$W_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \left(\frac{U_0}{d - \Delta d} \right)^2 S(d - \Delta d) = \frac{\varepsilon_0 S U_0^2}{2(d - \Delta d)}$$
$$C = \frac{2W_e}{U_0^2} = \frac{\varepsilon_0 S}{d - \Delta d}$$

故电容器的电容及能量的改变量分别为

$$\Delta C = C - C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d - \Delta d} - \frac{\varepsilon_0 S}{d} = \frac{\varepsilon_0 S \Delta d}{d (d - \Delta d)}$$
$$\Delta W_e = W_e - W_{e0} = \frac{\varepsilon_0 S U_0^2 \Delta d}{2d (d - \Delta d)}$$

(2) 在电荷 q 一定的条件下,未插入电介质板前,极板间的电场为 $E_0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{q}{\varepsilon_0 S}$

 $W_{e0} = \frac{q^2}{2C} = \frac{dq^2}{2\varepsilon S}$

当插入电介质板后,由介质分界面上的边界条件 $E_{1t}=E_{2t}$,有 $E_1=E_2=E$

再由高斯定理可得
$$E \varepsilon \Delta S + E \varepsilon_0 (S - \Delta S) = q$$

题 3.37 图(b)

此时的静电能量为
$$W_e = \frac{1}{2}qU = \frac{1}{2}\frac{q^2d}{\epsilon\Delta S + \epsilon_0(S - \Delta S)}$$

其电容为

$$C = \frac{\varepsilon \Delta S + \varepsilon_0 (S - \Delta S)}{d}$$

故电容器的电容及能量的改变量分别为

$$\Delta C = \frac{(\varepsilon - \varepsilon_0)\Delta S}{d}$$

$$\Delta W_e = -\frac{1}{2} \frac{(\varepsilon - \varepsilon_0)q^2 d}{\varepsilon_0 S[\varepsilon \Delta S + \varepsilon_0 (S - \Delta S)]}$$

如果不引入电位函数,静电问题也可以通过直接求解法求解 E 的微分方程而得解决。

(1) 证明:有源区
$$\boldsymbol{E}$$
 的微分方程为 $\nabla^2 \boldsymbol{E} = \frac{\nabla \rho_t}{\varepsilon_0}$, $\rho_t = \rho + \rho_P$;

(2) 证明:
$$\mathbf{E}$$
 的解是 $\mathbf{E} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\tau} \frac{\nabla' \rho_t}{R} d\tau'$

解 (1) 由
$$\nabla \times \mathbf{E} = 0$$
, 可得 $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = 0$, 即 $\nabla (\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = 0$

又

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} \nabla \cdot (\boldsymbol{D} - \boldsymbol{P}) = \frac{1}{\varepsilon_0} (\rho + \rho_P)$$
$$\nabla^2 \boldsymbol{E} = \frac{\nabla (\rho + \rho_P)}{\varepsilon_0} = \frac{\nabla \rho_t}{\varepsilon_0}$$

故得到

(2) 在直角坐标系中
$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{\nabla \rho_t}{\varepsilon_0}$$
的三个分量方程为

$$\nabla^2 E_x = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{\partial \rho_t}{\partial x} , \quad \nabla^2 E_y = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{\partial \rho_t}{\partial y} , \quad \nabla^2 E_z = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{\partial \rho_t}{\partial z}$$

其解分别为

$$\begin{split} E_{x} &= -\frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{\tau} \frac{1}{R} \frac{\partial \rho_{t}}{\partial x'} \, \mathrm{d}\tau' \\ E_{y} &= -\frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{\tau} \frac{1}{R} \frac{\partial \rho_{t}}{\partial y'} \, \mathrm{d}\tau' \\ E_{z} &= -\frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{\tau} \frac{1}{R} \frac{\partial \rho_{t}}{\partial z'} \, \mathrm{d}\tau' \end{split}$$

故

$$\begin{aligned} \boldsymbol{E} &= \boldsymbol{e}_{x} E_{x} + \boldsymbol{e}_{y} E_{y} + \boldsymbol{e}_{z} E_{z} = \\ &- \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{\tau} \frac{1}{R} [\boldsymbol{e}_{x} \frac{\partial \rho_{t}}{\partial x'} + \boldsymbol{e}_{y} \frac{\partial \rho_{t}}{\partial y'} + \boldsymbol{e}_{z} \frac{\partial \rho_{t}}{\partial z'}] d\tau' = - \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{\tau} \frac{\nabla' \rho_{t}}{R} d\tau' \end{aligned}$$

3.39 证明:
$$\int_{\tau} \nabla'(\frac{\rho_t}{R}) d\tau' = 0$$

解 由于
$$\nabla'(\frac{\rho_t}{R}) = \rho_t \nabla'(\frac{1}{R}) + \frac{\nabla' \rho_t}{R} = \rho_t \frac{\mathbf{R}}{R^3} + \frac{\nabla' \rho_t}{R}$$
 ,所以
$$\int_{\tau} \nabla'(\frac{\rho_t}{R}) d\tau' = \int_{\tau} \rho_t \frac{\mathbf{R}}{R^3} d\tau' + \int_{\tau} \frac{\nabla' \rho_t}{R} d\tau' = 4\pi \varepsilon_0 \mathbf{E} + \int_{\tau} \frac{\nabla' \rho_t}{R} d\tau'$$

由题 3. 38 (2) 可知 $\int_{\tau} \frac{\nabla' \rho_t}{R} d\tau' = -4\pi \varepsilon_0 E$

$$\int_{\tau} \nabla'(\frac{\rho_{t}}{R}) d\tau' = -4\pi\varepsilon_{0} \mathbf{E} + 4\pi\varepsilon_{0} \mathbf{E} = 0$$